



三洋半導体  
ニュース

No. 268 B  
NO86

## 2SB598NP, 2SD545NP

シリコンエピタキシャルプレーナ型トランジスタ  
低周波電力増幅一般, コンバータ, 電子ガバナ用

No.268A とさしかえてください。

### 暫定規格

2SB598NP, 2SD545NP は小型パッケージにもかかわらず 電流容量が大きく, 飽和特性,  $h_{FE}$  のリニアリティの極めて優れた コンプリメンタリペアトランジスタです。上述の用途のほか 卓電等の電源, リレードライバなど広範囲に利用できます。

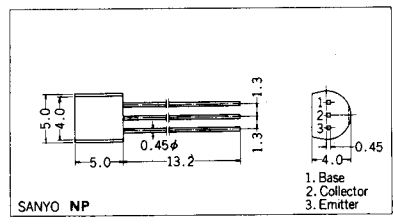
絶対最大定格 / $T_a = 25^\circ\text{C}$		2SB598NP	2SD545NP	
コレクタベース電圧	$V_{CBO}$	-25	25	V
コレクタエミッタ電圧	$V_{CEO}$	-25	25	V
エミッタベース電圧	$V_{EBO}$	-5	5	V
コレクタ電流	$I_C$	-1.0	1.0	A
	$i_{cp}$	-1.5	1.5	A
コレクタ損失	$P_C$	500	500	mW
接合部温度	$T_J$	125	125	$^\circ\text{C}$
保存周囲温度	$T_{stg}$	-40 ~ +125	-40 ~ +125	$^\circ\text{C}$

電气的特性 / $T_a = 25^\circ\text{C}$			[2SB598NP]			[2SD545NP]			unit
			min	typ	max	min	typ	max	
コレクタし断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = (-) 20V, I_E = 0$			-1.0			1.0	$\mu\text{A}$
エミッタし断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = (-) 4V, I_C = 0$			-1.0			1.0	$\mu\text{A}$
コレクタベース降伏電圧	$V(BR)_{CBO}$	$I_C = (-) 10\mu\text{A}, I_E = 0$	-25			25			V
コレクタエミッタ降伏電圧	$V(BR)_{CEO}$	$I_C = (-) 1\text{mA}, R_{BE} = \infty\Omega$	-25			25			V
エミッタベース降伏電圧	$V(BR)_{EBO}$	$I_E = (-) 10\mu\text{A}, I_C = 0$	-5			5			V
直流電流増幅率	$h_{FE}(1) \times$	$V_{CE} = (-) 2V, I_C = (-) 50\text{mA}$	60	$\times$	320	60	$\times$	320	
	$h_{FE}(2)$	$V_{CE} = (-) 2V, I_C = (-) 1\text{A(パルス)}$	30			30			
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE} = (-) 10V, I_C = (-) 50\text{mA}$		180			180		MHz
出力容量	$c_{ob}$	$V_{CB} = (-) 10V, f = 1\text{MHz}$		25			15		pF
C-E 飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = (-) 500\text{mA}, I_E = (-) 50\text{mA}$	-0.2	-0.5		0.1	0.3		V
B-E 飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = (-) 500\text{mA}, I_E = (-) 50\text{mA}$	-0.85	-1.2		0.85	1.2		V

$\times h_{FE}(1)$  は 2V, 50mA ポイントで次のように分類しています。

60	D	120	100	E	200	160	F	320
----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

外形 (単位: mm)



\* これらの仕様は、改良などのため予告なく変更することがあります。